

	<h2 style="color: red;">SI5402BDC-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI5402BDC-T1-GE3
	<b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 4.9A 1206-8
	<b>Datenblätter:</b>  SI5402BDC-T1-GE3.pdf
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	






### Spezifikationen

Teilenummer	SI5402BDC-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 4.9A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35 mOhm @ 4.9A, 10V
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Andere Namen	SI5402BDC-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 4.9A (Ta) 1.3W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.9A (Ta)

SI5402BDC-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5402BDC-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5402BDC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5402BDC-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI5401DC-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5.2A 1206-8</p>	 <p><b>SI5402DC</b> VISHAY SI5402DC VISHAY</p>	 <p><b>SI5402DC-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 4.9A 1206-8</p>	 <p><b>SI5401DC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 5.2A 1206-8</p>
 <p><b>SI5401DC-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5.2A 1206-8</p>	 <p><b>SI5402BDC-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 4.9A 1206-8</p>	 <p><b>SI5402DC-T1</b> SILICON SI5402DC-T1 SILICON</p>	 <p><b>SI5402BDC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 4.9A 1206-8</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI5402BDC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5402BDC-T1-GE3 Datenblatt	SI5402BDC-T1-GE3-Datenblätter	SI5402BDC-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SI5402BDC-T1-GE3 Electronic	SI5402BDC-T1-GE3-Komponenten	SI5402BDC-T1-GE3-Verteiler	SI5402BDC-T1-GE3-Bild	SI5402BDC-T1-GE3
SI5402BDC-T1-GE3 Preis	SI5402BDC-T1-GE3 Hersteller	SI5402BDC-T1-GE3 Bild	SI5402BDC-T1-GE3 Aktie	SI5402BDC-T1-GE3-Teil
SI5402BDC-T1-GE3 Neu	SI5402BDC-T1-GE3 Original	SI5402BDC-T1-GE3 garantiert	SI5402BDC-T1-GE3 RFQ	SI5402BDC-T1-GE3 Inventar
				SI5402BDC-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited